

**99-0249**

Изобретение относится к области радиоэлектронной техники и может быть использовано при получении гетероструктур тонких слоев бинарных соединений АПВ<sup>VI</sup> для изготовления фоторезисторов и фотопреобразователей.

Способ получения тонкопленочных гетероструктур на основе бинарных соединений АПВ<sup>VI</sup> включает осаждение в вакууме на подложке, при наличии градиента температур между испарителем и подложкой, слоя составляющих с узкозонной компонентой методом испарения в квазизамкнутом объеме с последующей термической и химической обработкой и слоя составляющих с широкозонной компонентой путем дискретного испарения.